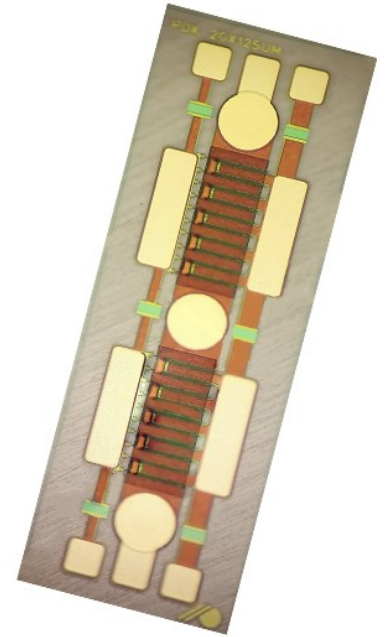


RT20

10 Вт, 0-18 ГГц, 28 В, GaN HEMT

Ascor RT20, это GaN транзистор с высокой подвижностью электронов на подложке из SiC, имеет высокий КПД, высокий коэффициент усиления, а также широкую рабочую полосу частот от 0 до 18 ГГц. Транзистор имеет характеристики соответствующие мировому уровню. Предназначен для использования в радиолокации и радиосвязи, имеют высокую надежность. Возможно изготовление транзисторов в керамическом корпусе с внутренними согласующими цепями.



ОСОБЕННОСТИ

- Верхняя частота: 18 ГГц
- Максимальная выходная СВЧ мощность: 10 Вт
- Максимальное усиление: 15-20 дБ, на 10 ГГц
- КПД не менее: 42%
- Напряжение питания: 28 В
- Размер кристалла: 0,54 x 1,4 мм

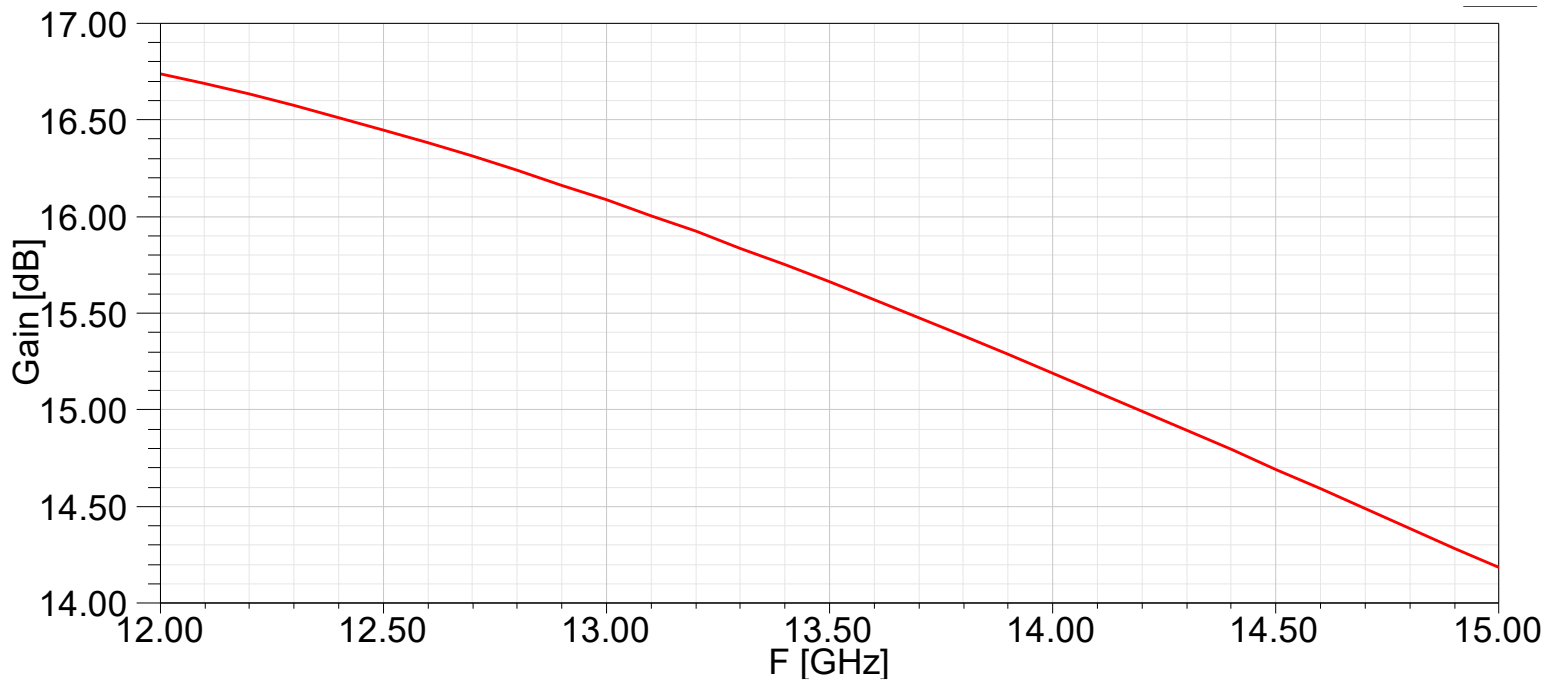
Электрические характеристики $T=25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{ds}=28\text{ В}$

Характеристика	Минимальное	Типичное	Максимальное	Ед. измерения	Условия
Ток сток-исток	654	743	831	мА/мм	$V_{gs}=0\text{ В}$
Ток сток-исток	925	996	1049	мА/мм	$V_{gs}=1\text{ В}$
Пороговое напряжение затвора	-2,94	-2,6	-2,28	В	
Напряжение пробоя затвор-сток	116	119	120	В	$V_g=-10\text{ В}$
Сопротивление включённого транзистора	2,5	2,7	3,3	Ом/мм	

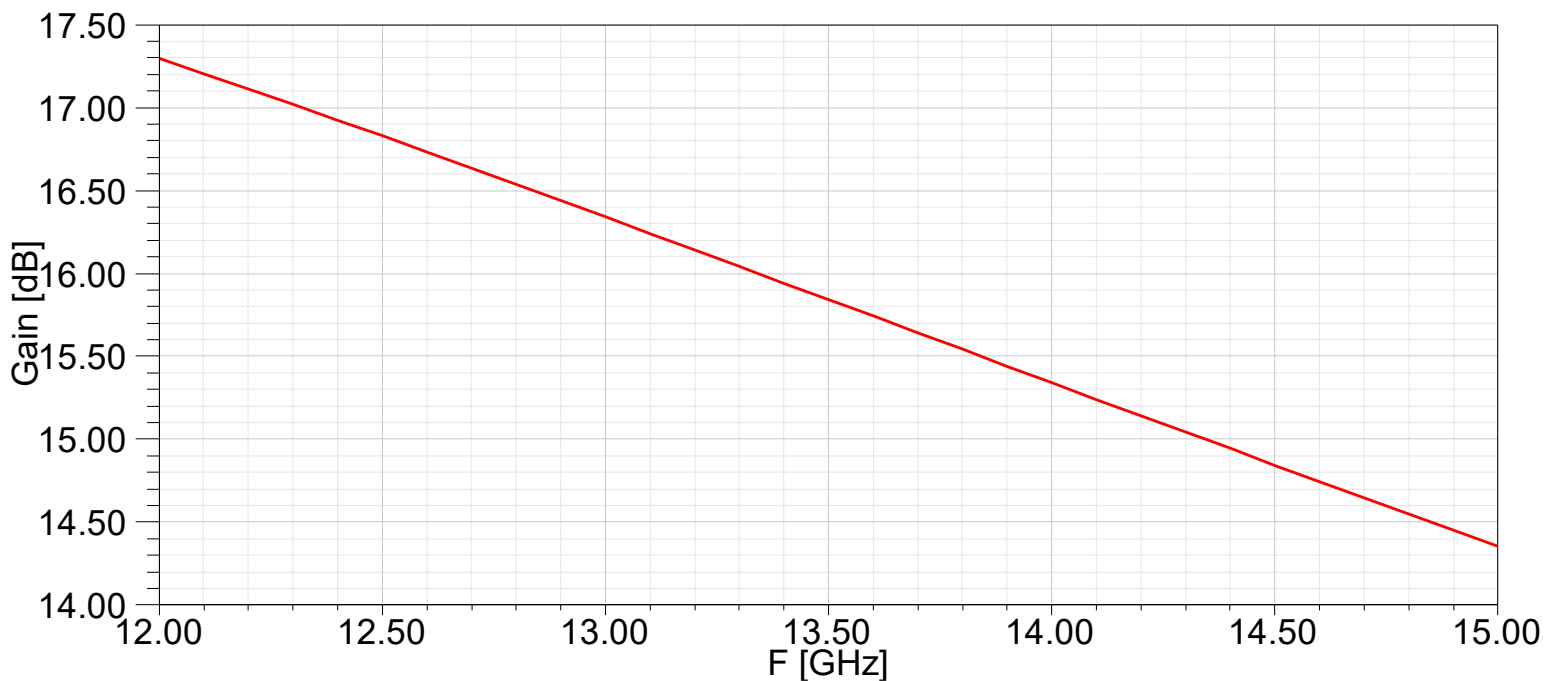
СВЧ характеристики $T=25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{ds}=28\text{ В}$

Характеристика	Минимальное	Типичное	Максимальное	Ед. измерения	Условия
Выходная мощность			10	Вт	
Коэффициент усиления		15	20	дБ	$f=10\text{ ГГц}$
КПД	42			%	
Частота	0		18	ГГц	

Частотная зависимость коэффициента усиления $T=25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{ds}=28\text{ В}$, $I_{ds}=80\text{ мА}$



Частотная зависимость коэффициента усиления $T=25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{ds}=28\text{ В}$, $I_{ds}=150\text{ мА}$



Частотная зависимость коэффициента усиления $T=25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{ds}=28\text{ В}$, $I_{ds}=250\text{ мА}$

